УДК 531.7.08+519.21

ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЙ В ЗАДАЧЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ТУННЕЛЬНОМ ЭЛЕКТРОННОМ МИКРОСКОПЕ

В. П. Манолов *), Ю. П. Пытьев

(кафедра компьютерных методов физики)

В линейном приближении исследована предельная разрешающая способность измерительно-вычислительной системы на базе сканирующего туннельного микроскопа. (СТМ). Определена последовательность классов поверхностей возрастающей размерности, в каждом из которых поверхность восстанавливается с максимальной точностью по результатам измерений на СТМ. Получены зависимости ошибки восстановления координат поверхностк от отношения шум/сигнал. Найдены условия оптимальности дискретизации измерений на СТМ, обеспечивающей предельно точное восстановление измеренной поверхности.

1. Введение

Сканирующий туннельный электронный микроскоп (СТМ) был создан в Цюрихском отделении IBM в 1981 г. группой БРГВ [1]. С тех



пор он себя зарекомендовал как мощное средство для изучения поверхностей.

Рассмотрим принцип действия СТМ стандартной конфигурации (рис. 1). Между иглой с очень малым радиусом кривизны острия и исследуе-

мым образцом подано напряжение V и протекает туннельный ток I_t . Игла может перемещаться относительно поверхности в трех направлениях. Если конец иглы движется вдоль исследуемой поверхности, из-за ее неровностей будет меняться туннельный ток $I_t = I_t(x, y)$. На практике чаще используется так называемый режим линии постоянного тока, при котором игла движется в плоскости 0xy и по направлению 0z так, что значение туннельного тока остается постоянным: $I_t = \text{const.}$ При этом регистрируются z-координаты иглы $\tilde{\xi}$ над некоторой сеткой на плоскости 0xy. Траектория, описываемая концом иглы, называется линией постоянного тока. В работе рассматривается задача оценивания реальной поверхности образца $\xi(x, y)$, $0 < x < x_0$, $0 < y < < y_0$ по результатам измерений на туннельном микроскопе либо значений I_t (задача (*)), либо $\tilde{\xi}$ (задача (**)).

*) Болгария.

Рис. 1. Схема стандартной конфигурации СТМ

2. Модель измерения

Решение задачи восстановления реальной поверхности образца по результатам измерений на СТМ в общем виде затруднительно, так как требует решения обратной задачи для системы трехмерных уравнений Шрёдингера и Пуассона. Поэтому после создания СТМ были рассмотрены упрощенные модели задачи. При решении задачи моделирования СТМ в рамках приближения свободных электронов была использована теория рассеяния [2, 3].

В настоящей работе применяется квазиклассическое приближение. Предположим, что между иглой и поверхностью образца поддерживается постоянный потенциал V. Для металлов при нормальных температурах можно считать, что все уровни в зоне проводимости ниже E_f будут заполненными, а выше — пустыми. Из-за этого туннельный ток формируется электронами, находящимися в тонкой зоне ниже E_f толщиной eV.

Рассмотрим ситуацию, показанную на рис. 1. Обозначим через п и п' векторы нормалей к двум поверхностям в точках соответственно A и A', d — вектор, соединяющий A и A'; φ и ϑ — углы между d и n, d и n' соответственно.

Пусть $k_0 = (2m\Phi)^{0.5}/\hbar$, где Φ — высота барьера с учетом поправки потенциала сил зеркального отражения [4]. В квазиклассическом приближении (ККП), когда игла находится достаточно далеко от исследуемой поверхности,

$$|\mathbf{d}| \gg 10k_0^{-1},\tag{1}$$

будем считать, что туннельный ток в системе игла—образец равняется сумме токов между элементарными площадками ds и ds', когда A, A' пробегают по всей поверхности иглы и образца. Вероятность туннелирования в приближении ВКБ дается выражением [5]

 $p_t = \exp\{-2k_0 |\mathbf{d}|\}.$

Ε.

В модели ККП для плотности туннельного тока j_t , протекающего между площадками ds и ds', получаем

$$\mathbf{j}_t = I_0 \cdot \mathbf{n}_d \cdot \exp\{-2k_0 |\mathbf{d}|\},$$

где

$$I_0 = \int_{E_s - eV}^{I} v_s(\varepsilon) v_t(\varepsilon) i(\varepsilon) d\varepsilon$$
(3)

и v_s , v_t обозначают поверхностные плотности электронных состояний при энергии ε соответственно в точках A и A'. Выражения (2), (3) написаны в предположении о независимости величины $i(\varepsilon)$ от угла выхода электрона.

Чтобы вычислить весь туннельный ток перехода, надо проинтегрировать (2) по поверхностям иглы и образца для заданного положения иглы. При этом для упрощения I_0 и k_0 будем считать константами.

Пусть *z*-проекция среднего расстояния вершины иглы до исследуемого участка образца равняется *D*₀. Напишем выражение для полного туннельного тока в принятой модели:

$$I_t(\mathbf{r}') = I_0 \int_{S} \int_{S'} ds \cdot ds' \cdot \cos \varphi \cdot \cos \vartheta \cdot \exp \{-2k_0(\mathbf{r}) |\mathbf{r}_t + \mathbf{r}' - \mathbf{r}|\} / |\mathbf{r}_t + \mathbf{r}' - \mathbf{r}|^2;$$

(4)

(2)

здесь S — область образца, S' — область иглы, \mathbf{r} — координаты площадки образца ds; \mathbf{r}' — координаты центра иглы O; \mathbf{r}_t — координаты площадки ds' на игле относительно ее центра.

Выражение (4) можно преобразовать к виду

$$I_{t}(\mathbf{r}') = I_{0} \int_{-\infty}^{\infty} C_{1} \frac{D_{\bullet} + R_{\bullet} + \nabla (\xi(\rho)) (\rho - \rho')}{d_{m}^{2} (d_{m} + R_{\bullet})} \exp\left\{-2k_{0}(\rho') d_{m}\right\} dx dy,$$
(5)

где

$$d_m(\mathbf{r}, \mathbf{r}') = \{ [D_0 + R_0 - \xi(\rho) + \widetilde{\xi}(\rho')]^2 + (\rho' - \rho)^2 \}^{1/2} - R_0, \\ \rho = (x, y), \ \rho' = (x', y').$$

Здесь вершина иглы моделируется полусферой радиуса R_0 , $C_1(\rho, \rho', D_0)$ зависит от конкретной используемой иглы, слабо меняясь в области, где exp{-} существенно отличается от 0.

Выражение (5) определяет модель измерения туннельного тока (•).

Дальше исследуем работу прибора для наглядности в двумерном случае. Двумерный вариант равенства (5) имеет вид

$$I_{t}(x') = C_{d} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{D_{0} + R + (x - x') (d\xi/dx)}{(R + d_{m}) d_{m}} \exp\{-2k_{0}d_{m}\} dx, \qquad (6)$$

$$d_{m}(x, x') = \{[D_{0} + R - \xi(x) + \xi(x')]^{2} + (x - x')^{2}\}^{1/2} - R.$$

При сравнении результатов этой модели с результатами [4] для небольших ξ и линии постоянного тока были обнаружены сходные зависимости отношений максимальных значений $\tilde{\xi}$ и ξ от R_0 , D_0 . При сравнении с экспериментальными данными группы БРГВ и [2] для иглы из вольфрама и поверхности из золота (100) (2×1), (3×1) наблюдается близость модельных (5) *) и экспериментальных максимальных значений $\tilde{\xi}$:

	Модель	Эксперимент
(2×1)	0,38 Å	0,45 Å
(3×1)	1.22 Å	1,40 Å

Приведенные результаты свидетельствуют о достаточно хорошем согласии модели с экспериментом, что позволяет использовать ее для исследования информативности измерения на СТМ.

Рассмотрим теперь случай, когда исследуемая поверхность мало отличается от плоскости, так что можно разложить $\exp\{\cdot\}$ в (6) в ряд по степеням (ξ — ξ) и учесть только линейный член. Это приближение справедливо для образца, шероховатость которого удовлетворяет условию

$$|\boldsymbol{\xi}| \ll k_0^{-1}.$$

(7)

Введем обозначение $d_{m0}(x, x') = d_m |_{\xi \to \tilde{\xi} \to 0}$. Если выполняются условия (1) и (7), получим

$$I_{t}(x') = C_{d1} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(D_{0} + R) \exp\{-2k_{0}d_{m0}\}}{(d_{m0} + R) d_{m0}} \{1 + K(x - x') \xi(x)\} dx,$$
(8)

где К — сложное рациональное выражение.

*) Для поверхности золота при этом использована модель [3].

Если обратная связь идеальна, она должна путем изменения $\tilde{\xi}$ обеспечить постоянство тока вдоль траектории иглы:

$$I_t(x') = I_{t0} = I_t|_{\xi = \tilde{\xi} = 0}.$$
(9)

Из (6) и (9) получается зависимость $\xi(x') = f(\xi(x), x')$ при условиях (1), (7), которая соответствует модели измерения (**):

$$\widetilde{\xi}(x') = C_{d_2} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(D_0 + R) \exp\{-2k_0 d_{m_0}\}}{(d_{m_0} + R) d_{m_0}} \cdot K(x - x') \cdot \xi(x) \, dx.$$
(10)

Зависимости (8), (10) — линейные интегральные уравнения с ядрами, мало отличающимися от const exp{— kd_{m0} }. Будем считать, что подынтегральная функция отлична от нуля в области от — $L_e/2$ до $L_e/2$, где $L_e \cong 3[(R+D_0)/k_0]^{0.5}$. Как принято в технике, L_e будем называть шириной аппаратной функции.

Следуя работе [5], рассмотрим задачу о нахождении $\xi(\cdot)$ при известном $Y_i(\cdot)$ (I_t или ξ). Схема измерения записывается в виде

$$y_i(x') = b_i + \int_{-L_e^{/2}}^{L_e^{/2}} dx A_i(x, x') \cdot \xi(x) + v(x'), \quad i = 1, 2,$$
(11)

$$A_{1}(x, x') = C_{d1} \frac{(D_{0} + R) \exp\{-k_{0}d_{m0}\}}{(d_{m0} + R) d_{m0}} K(x - x'), \quad b_{1} = I_{t0},$$

$$A_{2}(x, x') = C_{d2} \frac{(D_{0} + R) \exp\{-k_{0}d_{m0}\}}{(d_{m0} + R) d_{m0}} K(x - x'), \quad b_{2} = 0.$$

Измерение проводится с ошибкой v, иногда весьма значительной, возникающей из-за несовершенства двигателей иглы, шума усилителей туннельного тока, температурного дрейфа и случайных вибраций, погрешности дискретизации y_i и x'.

К этому нужно добавить неточность формул (8), (10) вследствие принятых приближений.

Как правило, исследователь может оценить погрешность измерения на своей конкретной экспериментальной установке, и мы будем считать ее известной и заданной посредством ковариационного оператора Σ . Идея определения информативности измерения на СТМ сводится к выяснению того, насколько последнее позволяет уточнить априорные данные об исследуемой поверхности. Априорная информация о поверхности может быть разного типа. Зададим модель поверхности в виде случайной функции с известными первыми двумя моментами: средним значением $E\xi=0$ и ковариационным оператором F. Для нашей цели ограничимся моделью с диагональным ковариационным оператором $F=\varphi^2 I$, согласно которой значения ξ в соседних точках некоррелированы. При этом не вводится никаких априорных ограничений на гладкость поверхности. Для моделирования измерений на СТМ положим $\Sigma=\sigma^2 I$. Таким образом, мы задали модель $[A, F, \Sigma]$ [6] схемы измерения (11).

Дискретный вариант схемы (11) имеет вид равенства

$$y = A\xi + b + v$$
,

(12)

где y, b, $v \in \mathfrak{N}_n$, $\xi \in \mathfrak{N}_N$, A — матрица $n \times N$. Для заданного шага дискретизации Δ и определенной длины L строки сканирования $N = (L + + L_e)/\Delta$; $n = L/\Delta$.

Размерность области измерения *п* меньше размерности *N* просканированной области, поэтому точное восстановление ξ в тех же точках невозможно даже при погрешности v=0. В таких случаях иногда прибегают к восстановлению поверхности в более редких точках. Мы рассмотрим вопрос о предельных возможностях восстановления по данным измерения на СТМ. Речь идет о характеристиках поверхности, которые могут быть восстановлены с гарантированной точностью по результатам измерений. Для этого обратимся к понятию базиса модели [7]. Так называется ортонормированный базис $\{e_1, ..., e_N\}$ пространства $\Re_N \cong \xi$, состоящий из собственных векторов оператора $A*\Sigma^{-1}A + F^{-1}$, определяющего оценку среднеквадратичной погрешности,

$$(A^*\Sigma^{-1}A + F^{-1}) e_p = \delta_p^2 e_p, \quad p = 1, \dots, N,$$
(13)

$$\delta_1^2 \geqslant \delta_2^2 \geqslant \ldots \geqslant \delta_N^2. \tag{14}$$

Этот базис обладает следующим экстремальным свойством: в каждом из линейных пространств

$$\mathfrak{L}(e_1) \subset \mathfrak{L}(e_1, e_2) \subset \ldots \subset \mathfrak{L}(e_1, e_2, \ldots, e_R) = \mathfrak{R}_N \tag{15}$$

шум будет не больше, чем в любом другом подпространстве $\Re N$ той же или большей размерности^{*)}. Иначе говоря, если Π_k — ортогональный проектор на $\mathfrak{L}(e_1, ..., e_k)$, то «*k*-мерная часть» $\Pi_k \xi$ поверхности ξ может быть восстановлена точнее любой другой «*k*-мерной части» ξ [7].

Определим искомые характеристики поверхности ξ в виде $U\xi$, где U — линейный оператор, задающий преобразование поверхности ξ как вектора из \Re_N . Оператор R' и вектор b', минимизирующие среднеквадратичную погрешность $E ||R(y-b) - U\xi||^2$, даются равенствами [7]

$$R' = UFA^* (AFA^* + \Sigma)^{-1}, \quad b' = 0.$$
(16)

Оцениванию *U*[§] посредством *R'y* будет сопутствовать среднеквадратичная погрешность

$$E || R'y - U\xi ||^{2} = \operatorname{tr} (UF - UFA^{*} (AFA^{*} + \Sigma)^{-1} AFU^{*}) = \operatorname{tr} (U (A^{*}\Sigma^{-1}A + F^{-1})^{-1} U^{*}),$$
(17)

и задача состоит в том, чтобы оценить как можно точнее возможно более «полную часть ξ », выбрав должным образом оператор U. Положив $U \equiv \Pi_k$, мы гарантируем наиболее точное восстановление «k-мерной части» поверхности $\Pi_k \xi$ по сравнению с любой ее «k-мерной частью». Так как

$$E || \Pi_{k} (FA^{*} (AFA^{*} + \Sigma)^{-1} y - \xi) ||^{2} = \sum_{p=1}^{k} \delta_{p}^{-2}, \qquad (18)$$

то вопрос о выборе размерности k может быть решен следующим образом. Поскольку в рассматриваемой модели поверхности $F = \varphi^2 \cdot I =$ =diag (φ^2 , ..., φ^2), где φ^2 — среднеквадратичное уклонение координат искомой поверхности от плоскости $\xi = 0$, то в равенстве (13)

 $\delta_p^2 = \varphi^{-2} + \alpha_p^2 / \sigma^2, \quad k = 1, \ldots, N,$

где $a_1^2 \ge ... \ge a_N^2$ — собственные значения оператора A^*A , и соответственно в (18)

*) $\mathfrak{L}(e_1 \ldots e_k)$ — линейная оболочка векторов $e_1 \ldots e_k$.

$$\sum_{p=1}^{k} \delta_{p}^{-2} = \sum_{p=1}^{k} \varphi^{2} \left(1 - \frac{\alpha_{p}^{2}}{\beta^{2} + \alpha_{p}^{2}} \right).$$

Здесь $\sum_{p=1}^{p} \varphi^2 = k\varphi^2$ среднеквадратичная погрешность, отвечающая оцениванию $\Pi_k \xi$ плоскостью $\xi = 0$, вычитаемое в (19) определяет увеличение точности оценивания, обусловленное измерениями на СТМ, $\beta^2 = \sigma^2/\varphi^2$ отношение «шум/сигнал». При этом каждое слагаемое δ_p^{-2} равно среднеквадратичной ошибке оценивания координаты (e_p , ξ) восстанавливаемой части $\Pi_k \xi = \sum_{1}^{k} e_p (e_p, \xi)$ поверхности. Поскольку $\alpha^2/(\beta^2 + \alpha^2)$ монотонно возрастающая функция от $\alpha^2 > 0$, с увеличением p точность оценивания p-й координаты (e_p , ξ) уменьшается и если считать, что эффективно оцениваются лишь те координаты, для которых $\alpha_p^2/(\beta^2 + \alpha_p^2) \ge \mu$, $0 < \mu < 1$, то размерность k проектора Π_k определяется из условия

$$k = \max(p, \alpha_p^2 \ge \mu (1-\mu)^{-1} \beta^2).$$

Для примера рассмотрим результаты при $k_0=0,5$ Å⁻¹, R=2 Å, $D_0=4$ Å. Выберем $\Delta=1$ Å, N=45. Дискретизованная аппаратная функция, определенная в выражении (11), показана на рис. 2. На рис. 3, б приведен график зависимости $h=1-\alpha_p^2/(\beta^2+\alpha_p^2)$ от p для различных значений отношения «шум/сигнал» $\beta^2=\sigma^2/\varphi^2$. Величина $1-\alpha_p^2(\beta^2+\alpha_p^2)$ равна относительной «погрешности оценивания p-й гармоники» (ξ , e_p) поверхно-



Рис. 2. Нормированная аппаратная функция A(x, x') = A(x-x')

сти § при значении отношения «шум/сигнал», равном β^2 . Эти зависимости позволяют легко оценить реальную разрешающую способность СТМ. Например, с относительной погрешностью «не хуже 0,5» могут быть восстановлены 10 гармоник, если $\beta^2=0,0025$, а при $\beta^2=-0,25$ — всего лишь 5.

Разумеется, этот результат зависит от характера дискретизации данных сканирования. На рис. 3, а приведены те же результаты для другой плотности точек сканирования, соответствующей шагу измерений $\Delta = 1,5$ Å (N = 30). Нетрудно заметить различия двух графиков. Но различие между результатами, отвечающими шагам 1 Å и 0,5 Å, несущественно, и это говорит о том, что при шаге дискретизации $\Delta = 1$ Å графики на рис. 3, б характеризуют предельные свойства принятой модели СТМ.

В вычислительном эксперименте задавались произвольные формы поверхности § и разные уровни измерительной погрешности. Значения

(19)

ξ и I_t находились из зависимостей (6), шум учитывался путем добавления нормально распределенной случайной величины.



. Рис. 3. Семейства зависимостей погрешности восстановления координат поверхности h от p для различных отношений шум/сигнал β =0,05, 0,1; 0,2 и 0,5 при шаге сканирования 1,5 Å (a) и 1,0 Å (b)

На рис. 4 показаны результаты, иллюстрирующие предельные возможности измерительно-вычислительной системы на базе СТМ при вос-



Рис. Восстановление поверх-4 ностей, принадлежащих линейной оболочке первых 5 (а); первых 10 (б); первых 15 (в) век-Сплошной торов базиса модели. линией изображена задаваемая поверхность, точечной -— линия постоянного тока в нелинейной модели (6) с добавлением шума $(\beta = 0,1),$ штриховой — восстановленная поверхность

становлении поверхностей, состоящих из линейных комбинаций первых 5 (рис. 4, a), 10 (4, b), 15 (4, a) векторов базиса модели. Отношение шум/сигнал задавалось одинаково: $\beta=0,1$.

При известном отношении шум/сигнал β и заданной исследователем величине относительной погрешности восстановленного сигнала h_0 реконструированная часть поверхности будет состоять из первых kвекторов базиса модели, где k удовлетворяет условию

$$\sum_{i=1}^{k} 1 - \alpha_i^2 / (\beta^2 + \alpha^2) \leqslant h_0 < \sum_{i=1}^{k+1} 1 - \alpha_{i+1}^2 / (\beta^2 + \alpha^2).$$
(20)

ЛИТЕРАТУРА

[1] Binning G., Rohrer H., Gerber Ch., Weibel E.//J. Appl. Phys. Lett. 1982. 40. Р. 178; Phys. Rev. Lett. 1982. 49. Р. 57. [2] Garsia N., Ocal C., Flores F.//Phys. Rev. Lett. 1983. 50. Р. 2002. [3] Stoll E., Baratofi A., Selloni A., Carnevali P.//J. Phys. C.: Solid State Phys. 1984. 17. Р. 3073. [4] Tersofi J., Hamann D. R.//Phys. Rev. Lett. 1983. 50. Р. 1998. [5] Туннельные явления в твердых телах/Под ред. Э. Бурштейна, С. Лундквиста. М., 1973. [6] Пытьев Ю. П. Математические методы интерпретации эксперимента. М., 1988. [7] Пытьев Ю. П. Методы анализа и интерпретации эксперимента. М., 1990.

Поступила в редакцию 03.02.93

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3, ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ. 1993. Т. 34, № 6

АТОМНАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА

УДК 539.17

МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ЭМИССИЯ Y-КВАНТОВ В РЕАКЦИИ ЗАХВАТА НЕИТРОНА ЯДРОМ ПРИ СРЕДНИХ ЭНЕРГИЯХ

Ф. А. Живописцев, В. А. Иванов, Хурэлсух Сэр-Одын *) (НИИЯФ)

Обсуждаются возможности описания неравновесного γ -спектра в реакции (n, γ) при $\mathcal{E}_n = 14, 1$ МэВ в рамках квантовой модели статистических многоступенчатых компаунд-процессов (СМКП) и статистических многоступенчатых прямых процессов (СМПП). Показано, что можно достигнуть согласованного описания экспериментальных данных для реакций (n, γ) при $\mathcal{E}_n = 14, 1$ МэВ на ядрах. ⁹³Nb, ¹³³Cs при учете вкладов 1СПП, 2 СПП, СМПК и равновесной γ -эмиссии.

1. Введение

Теоретическое исследование неравновесного γ -спектра, полученното в реакции (n, γ) при средних энергиях ($\mathscr{E}_n > 10$ МэВ), в ряде работ $\{1-3\}$ проводилось в рамках феноменологической экситонной модели (ЭМ) предравновесного распада. Однако даже в случае удовлетворительного количественного описания экспериментальных данных в рамках ЭМ вопрос о ее физической интерпретации в большой степени остается открытым, поскольку ЭМ присущи следующие основные недостатки [4]:

1) неопределенность величины единого усредненного квадрата матричного элемента внутриядерного перехода (\overline{V}^2) (свободный параметр) и плотности одночастичных состояний (g) при одновременном рассмотрении статистических многоступенчатых прямых процессов (СМПП) и компаунд-процессов (СМКП);

2) некорректное применение принципа детального баланса, использование ненаблюдаемой величины сечения обратной реакции возбужденного ядра;

3) невозможность последовательного учета одноступенчатой прямой реакции, отсюда и неопределенность подгоняемого под эксперимент начального числа экситонов (N_0) , в частности, для реакции (n, γ) $N_0=1$ либо 3. Выбор $N_0=1$ противоречит понятию сечения поглощения, определяемого через мнимую часть оптического потенциала. Поэтому ЭМ в настоящее время служит в основном для ориентировки и

*) Монголия.